

Исследование диэлектрического старения в слоистых сегнетоэлектриках

© Ю.В. Кочергин, А.И. Бурханов, К. Борманис*, А. Калване*, М. Дамбекалне*

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
Волгоград, Россия

* Институт физики твердого тела Латвийского университета,
Рига, Латвия

E-mail: burkhanov@inbox.ru

Исследованы особенности процесса долговременной релаксации поляризации в керамике $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ при различной предыстории. Установлено, что в $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ в зависимости от режима измерений, включающих в себя нагрев или охлаждение до исследуемой температурной точки T_a , изменяется тип временного зависимости $\epsilon'(t)$, описывающей диэлектрическое старение материала при $T_a = \text{const}$. Результаты обсуждаются в рамках возможности существования дефектных комплексов в неупорядоченных сегнетоэлектриках.

PACS: 77.22.Ch, 77.84.Dy

Образуя непрерывный ряд твердых растворов, представители слоистых сегнетоэлектриков (СЭ) являются эффективными сегнетоматериалами с широко варьируемыми характеристиками [1]. Это делает их актуальными материалами не только с прикладной, но и с фундаментальной точки зрения, так как позволяет более детально исследовать механизмы релаксации поляризации, происходящие в неупорядоченных средах. Известно, что в материалах с размытыми фазовыми переходами большую роль играют процессы, связанные с предысторией материала [2,3]. В то же время исследований по влиянию различных режимов измерений (или предыстории) в слоистых СЭ по сравнению с такими измерениями в релаксорных сегнетоэлектриках явно недостаточно для однозначного понимания процессов релаксации поляризации в такого рода структурах. Целью настоящей работы являлось изучение особенностей диэлектрического старения слоистых СЭ $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$.

Для исследования были выбраны керамические образцы соединений $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$. Образцы были изготовлены из тонкоизмельченных оксидов и карбонатов соответствующих элементов методом твердофазного синтеза при температуре 1120–1220 K с последующим обжигом при 1320–1370 K. Для измерений использовали образцы в виде плоскопараллельных пластин толщиной 1.02 mm и площадью 58 mm². Электроды наносились путем вжигания серебряной пасты.

Измерения комплексной диэлектрической проницаемости ($\epsilon^* = \epsilon' - i\epsilon''$) проводились на установке мостового типа в области частот от 0.25 до 1000 Hz в слабых полях ($E \leq 1 \text{ V/cm}^{-1}$) в диапазоне температур 290–470 K в следующих режимах: а) нагрев до 470 K, затем охлаждение до температур, соответствующих максимумам $\epsilon'(T)$, и длительная выдержка, при которой определялся характер временного изменения диэлектрической проницаемости $\epsilon'(t)$; б) нагрев до температур, со-

ответствующих максимумам $\epsilon'(T)$, длительная выдержка и определение $\epsilon'(t)$.

Из рис. 1, a видно, что у состава $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Na}_4\text{O}_{27}$ в частотном интервале от 100 Hz и ниже проявляется размытый максимум $\epsilon'(T)$ в области температур 390–410 K. При этом данные температуры расположены существенно ниже T_c [3]. Такой характер диэлектрического отклика возникает только при режиме нагрева „состаренных“ образцов. При последующем охлаждении от высоких температур максимумы $\epsilon'(T)$ исчезают (рис. 1, c). Качественно подобное поведение температурных зависимостей $\epsilon'(T)$ проявляется и в составе $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ с такой же предысторией (рис. 1, b, d). В то же время в низкотемпературной области у $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ наблюдается выраженный (по сравнению с $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$) рост ϵ' на всех частотах с понижением температуры.

Рис. 2 иллюстрирует поведение временных зависимостей $\epsilon'(t)$ при различной предыстории образцов $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ для выбранных температур старения. В первом случае (рис. 2, a) временные зависимости получены после нагрева материала до температуры 450 K, которая на 330 K выше температуры максимума диэлектрической проницаемости $\epsilon'(T)$ (рис. 1, a), и охлаждения до температуры старения T_a , соответствующей данному максимуму $\epsilon'(T)$ ($T_a \approx 390$ K). Видно, что на протяжении всего времени измерения ($t > 7000$ min) заметных изменений ϵ' не проявляется, т.е. в данном случае диэлектрического старения нет.

Если же измерение временных зависимостей $\epsilon'(T)$ происходит после нагрева до температур, не превышающих температуру максимума $\epsilon'(T)$ (рис. 1, a), то картина существенным образом меняется (рис. 2, c). Из рис. 2, c следует, что значения $\epsilon'(t)$ в начальный момент времени соответствуют тем значениям $\epsilon'(t)$, которые наблюдаются в максимуме $\epsilon'(T)$ (рис. 1, a). При этом наблюдается существенная зависимость процесса

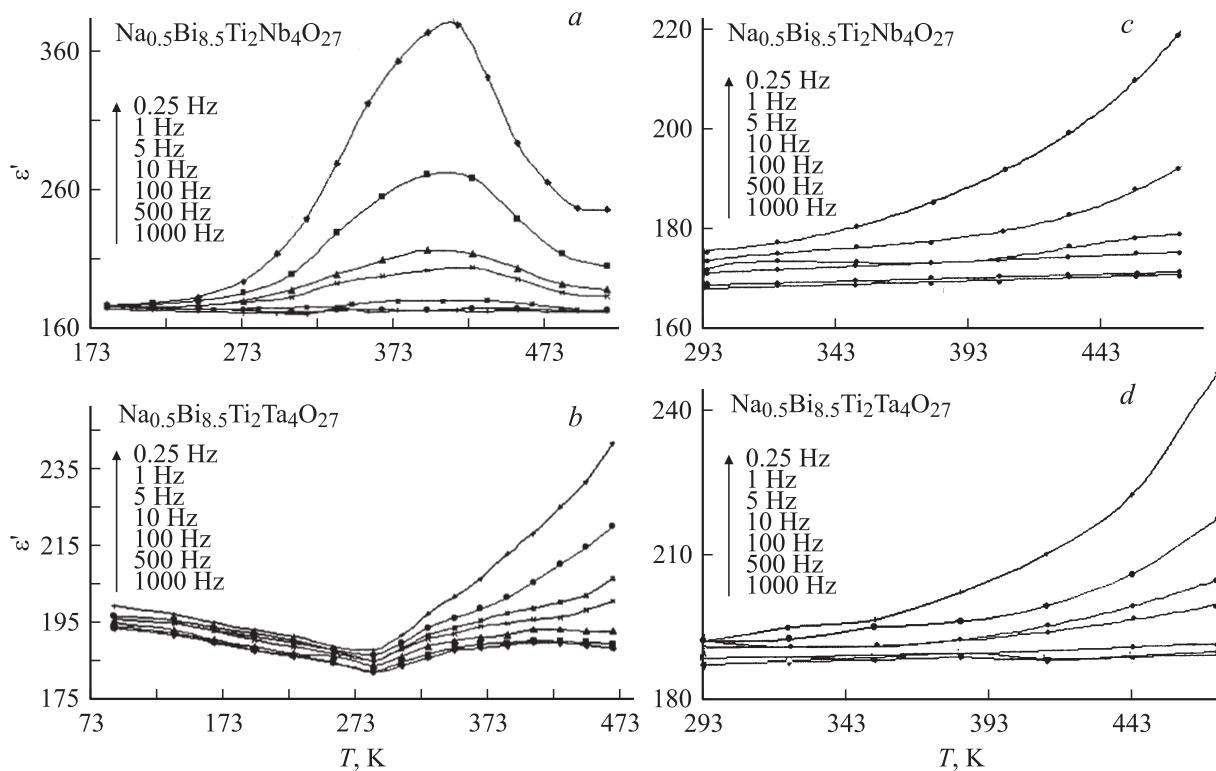


Рис. 1. Температурные зависимости $\epsilon'(T)$ в режимах нагрева (a, b) и охлаждения от высоких температур (c, d) „состаренной“ керамики $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ (a, c) и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ (b, d).

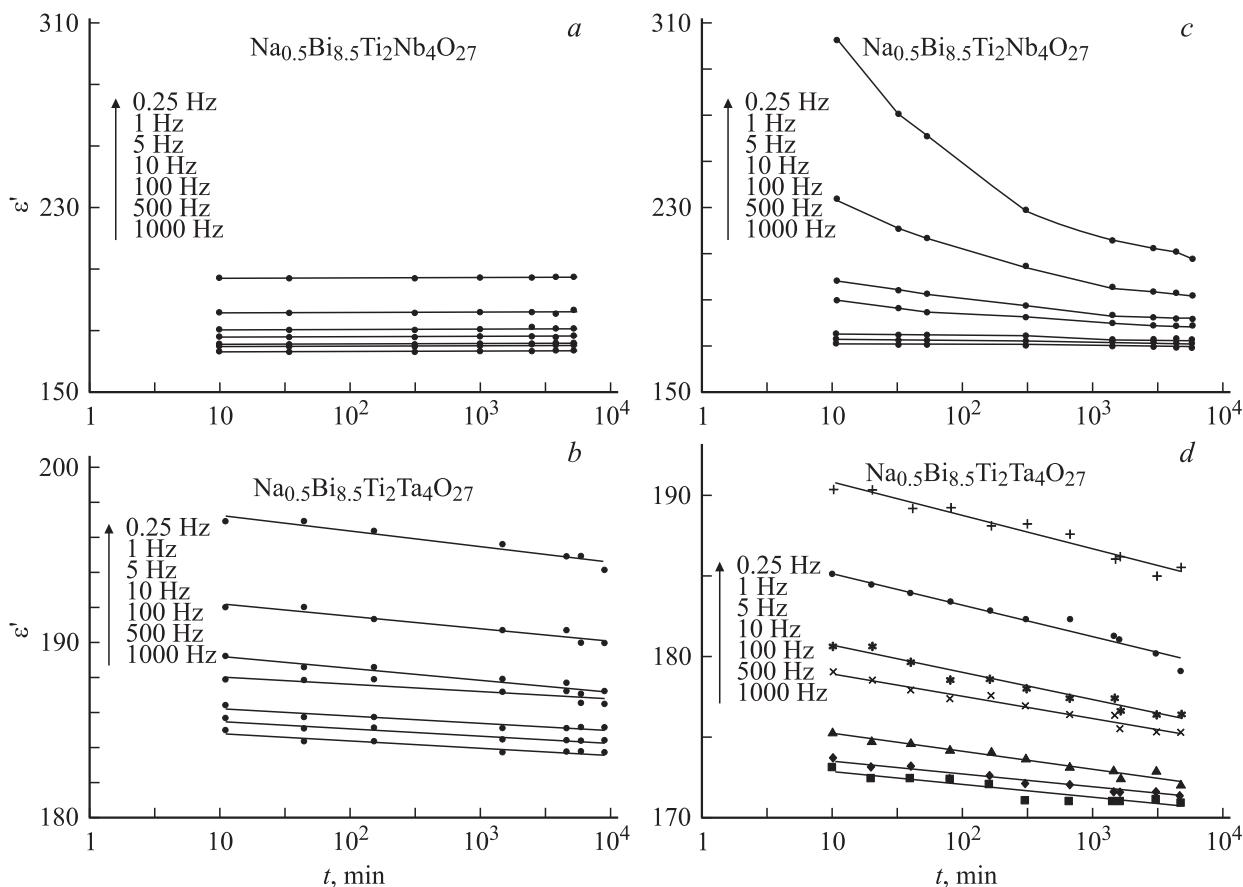


Рис. 2. Временные зависимости $\epsilon'(t)$ при постоянной температуре T_a после охлаждения к T_a от высоких температур (a, b) и нагрева к T_a (c, d) керамики $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ (a, c) и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ (b, d).

диэлектрического старения от частоты измерительного поля. Анализ типа временной зависимости $\epsilon'(t)$ для данного случая (рис. 2, c) показал, что на инфразвуковых частотах зависимость $\epsilon'(T)$, описывающая диэлектрическое старение, является растянутой экспонентой, или функцией Кольрауза: $\epsilon'(T) = A + B \exp(t/\tau)^\alpha$, где A и B — постоянные эксперимента, τ — время релаксации. При этом с повышением частоты от 0.25 до 5 Hz параметр α , определяющий степень „растянутости“ экспоненциальной функции, существенным образом уменьшается (от 0.21 до 0.12 соответственно), что может указывать на постепенное увеличение размытия спектра времен (частот) релаксаторов, участвующих в процессе старения. При более высоких частотах (10–1000 Hz) временные зависимости $\epsilon'(t)$ подчиняются логарифмическому закону: $\epsilon'(T) = A_1 + B_1 \ln(t/t_0)$, где A_1 и B_1 — постоянные эксперимента, t_0 — начальное время. Для состава $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$, как следует из рис. 2, b, d, логарифмическому закону следуют все временные зависимости $\epsilon'(t)$.

Таким образом, из двух приведенных случаев мы видим, что картина старения в керамиках $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Nb}_4\text{O}_{27}$ и $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{8.5}\text{Ti}_2\text{Ta}_4\text{O}_{27}$ заметным образом отличается лишь на инфразвуковых частотах ($\nu < 5 \text{ Hz}$). Учитывая, что имеет место гетеровалентность ионов в позициях A и B решетки в составе $\text{Bi}_2\text{A}_{1/6}\text{Bi}_{5/6}\text{Ti}_{2/3}\text{B}_{4/3}\text{O}_9$, где $A = \text{Na}^+$, $B = \text{Nb}^{5+}$, Ta^{5+} , можно предположить, что даже при статистическом распределении в среднем каждый шестой перовскитоподобный слой или каждая шестая позиция между октаэдрами BO_6 в плоскости слоя содержит ион A^+ вместо иона Bi^{3+} [3]. Это приводит к крупномасштабным флюктуациям заряда, или, согласно работе [4], образуется крупномасштабный флюктуационный потенциал. По-видимому, такой потенциал, или случайное поле, может приводить к скоплению различного рода дефектов (появлению кластеров), которые можно рассматривать в качестве отдельных эффективных ионов, определяющих причину существенной диэлектрической релаксации на инфразвуковых частотах. При относительно высоких частотах $\nu > 5–10 \text{ Hz}$ вклад их уменьшается, или они полностью выключаются из процесса релаксации поляризации.

То, что после отжига мы не наблюдаем ни максимума $\epsilon'(T)$ на инфразвуковых частотах, ни существенной релаксации в характере временных зависимостей $\epsilon'(t)$, по-видимому, свидетельствует о том, что нагрев до $T \approx 470 \text{ K}$ полностью разрушает упомянутую выше структуру комплекса дефектов. Отсюда следует, что после отжига образцов диэлектрическое старение в исследуемом диапазоне частот будет определяться обычным, характерным для СЭ, находящихся в полярной фазе, процессом старения, включающим в себя пиннинг доменных и фазовых границ на дефектах структуры материалов, обусловливающих тем самым выполнение логарифмического закона, описывающего спад ϵ' с течением времени.

Список литературы

- [1] Г.А. Смоленский, В.А. Боков, В.А. Исповедев, Н.Н. Крайник, Р.Е. Пасынков, А.И. Соколов, Н.К. Юшин. Физика сегнетоэлектрических явлений. Наука, Л. (1985). 360 с.
- [2] А.И. Бурханов. Автореф. докт. дис. ВГТУ, Воронеж (2004). 32 с.
- [3] А.А. Спрогис, Л.А. Шебанов, В.И. Димза, А.И. Калване. Фазовые переходы и сопутствующие им явления в сегнетоэлектриках / Отв. ред. Л.А. Шебанов. Латв. гос. ун-т, Рига (1984). 64 с.
- [4] В.Б. Сандомирский. ФТТ 24, 3318 (1982).